

G-დოპირებული მზის ელემენტების ტექნოლოგია და ელექტრული მახასიათებლები

ცოტნე ხიხლაშვილი

*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტზე მასალათმცოდნეობის მაგისტრის
აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნის შესაბამისად*

პროგრამა:

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკასა და ნანოინჟინერიისთვის

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ავთანდილ თავხელიძე, სრული პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2017

სარჩევი

შესავალი.....	3
ნანოტექნოლოგიის არსი.....	5
G- დოპირების თეორია.....	6
ლიტერატურის მიმოხილვა	
G-დოპირებული p-n გადასასვლელის მიღება	7
მზის ელემენტის მუშაობის პრინციპი.....	10
მეთოდთა	
ფოტოლიტოგრაფია	11
ინტერფერენციული ლიტოგრაფია.....	12
მზის ელემენტის დამზადების ტექნოლოგია.....	15
გაზომვის მეთოდოლოგია	18
შედეგები	
შედეგები და მათი განხილვა	19
დასკვნა	22
ბიბლიოგრაფია	23